

## 2SD458

## シリコン NPN 三重拡散メサ型/Si NPN Triple Diffused Junction Mesa

## 大電力増幅用/High Power Amplifier

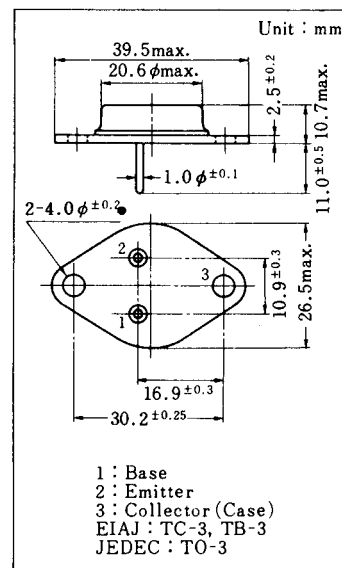
## スイッチング用/Switching

## 特 徴/Features

- コレクタ損失  $P_C$  が大きい。/Large collector dissipation
- コレクタ・エミッタ電圧  $V_{CEO}$  が大きい。/High  $V_{CEO}$

最大定格/Absolute Maximum Ratings ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	600	V
コレクタ・エミッタ電圧 ( $R_{BE}=50\Omega$ )	$V_{CER}$	600	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	400	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$I_{CM}$	10	A
コレクタ電流	$I_C$	5	A
せん頭ベース電流	$I_{BM}$	3	A
ベース電流	$I_B$	2	A
コレクタ損失( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	$P_C$	80	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-65~+150	$^\circ\text{C}$

電気的特性/Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	$I_C=10\text{mA}$ , $I_B=0$	400			V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	$I_E=1\text{mA}$ , $I_C=0$	5			V
コレクタシャ断電流	$I_{CER}$	$V_{CE}=600\text{V}$ , $R_{BE}=50\Omega$			1.0	mA
直流電流増幅率	$h_{FE}^*$	$V_{CE}=5\text{V}$ , $I_C=5\text{A}$	6.5		50	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5\text{A}$ , $I_B=1\text{A}$			1.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=5\text{A}$ , $I_B=1\text{A}$			3.0	V

\*  $h_{FE}$  ランク分類/ $h_{FE}$  Classifications

$h_{FE}$	15~50	6.5~30
分類	Q	R